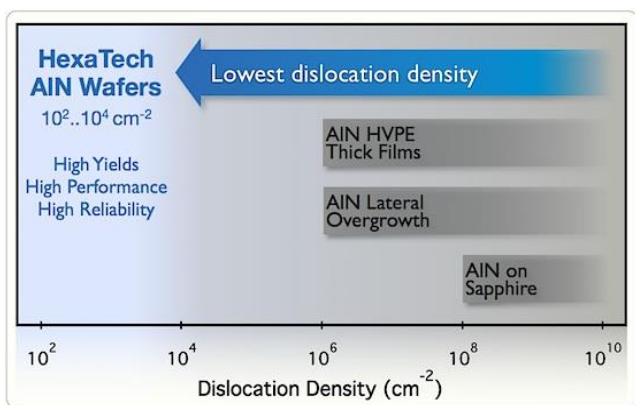


AlN(窒化アルミニウム)半導体基板製品

製品特徴

次世代の半導体および光半導体デバイスには材料の進化が必要です。深紫外光源デバイス、高性能電力変換デバイス、および高周波デバイスはすべて、Al 濃度の高い(通常 60%超)エピタキシャル層を用いて製造されます。これらの高性能デバイスを高精度に製造するには、エピタキシャル層を高品質な AlN 基板上に形成する事が重要となります。

AlNを使用しない場合、代替手法としてサファイアや炭化ケイ素(SiC)などの基板にIII族窒化物半導体を形成する事になりますが、発生する結晶欠陥を防ぐために特殊で高価な製造技術を導入する必要があり、市場の求める性能や信頼性にも届かないため、最善の手法とは言えません。



HexaTech の高品質な AlN 基板上に半導体を積層し製造することで、発生する欠陥が代替手法と比べて 10,000~1,000,000 倍も少なくなります。HexaTech の高品質 AlN 基板は、優れた性能、信頼性、および生産歩留まりを実現します。

HexaTech は現在、c 面および m 面配向の単結晶 AlN 基板を提供しています。

製品仕様

品番	配向	紫外透過性	アプリケーション例
AlN-10	c 面	無	高周波デバイス、圧電デバイス、深紫外レーザー
AlN-20	m 面	無	パワーデバイス、深紫外レーザー
AlN-30	c 面	有	深紫外 LED

利用可能なウェーハサイズ、価格、およびリードタイムの詳細については、HexaTech のセールス、またはスタンレー電気のセールスにお問い合わせください。

スタンレー電気株式会社 光半導体事業部 光半導体事業企画部 商品企画課

お問合せ：WEB サイトのお問合せフォームからお問合せ下さい

⇒WEB サイト: [リンク](#) ⇒お問合せフォーム: [リンク](#)